

IMB14A

アイソレーテッドミニモールドデバイス/Isolated Mini-Mold Device
エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ (抵抗内蔵タイプ)
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistor (Includes Resistors)
インバータドライバ/Inverter Driver

デジタルトランジスタ

2 素子内蔵 6 端子タイプ

● 特長

- 1) SMT(SC-59)と同一体積に 2 個のデジタルトランジスタが入っている。
- 2) SMT の自動装着機により装着が可能である。
- 3) 各デジタルトランジスタの素子間は独立しているため、相互干渉がない。
- 4) 実装コストおよび面積が半減できる。

● Features

- 1) Two digital transistors are housed in the same volume as SMT(SC-59).
- 2) The automatic mounting machine of SMT can be used for mounting.
- 3) No mutual interference exists between each transistor.
- 4) This device can cut the assembling cost and mounting area by half.

以下の特性は DT_{r1}, DT_{r2} について共通です。

The following characteristics are common for DT_{r1} and DT_{r2}.

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

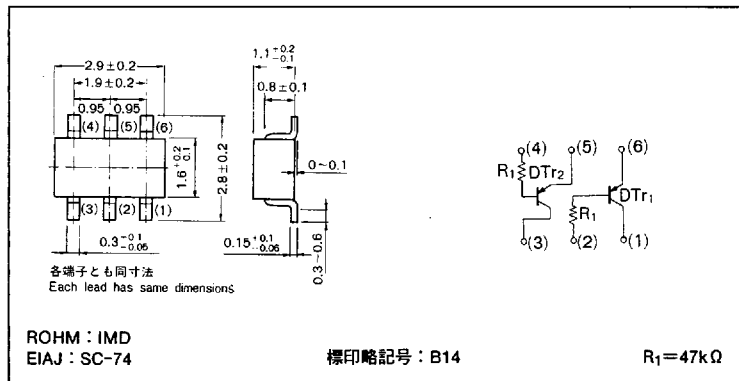
Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I _C	-100	mA
許容損失	P _d	300 (TOTAL)*	mW
保存温度範囲	T _{stg}	-55~150	°C

* ただし 1 素子当り 200mW をこえないこと。
However 200mW should not be exceeded per element.

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CB0}	-50	—	—	V	I _C =-50μA
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	-50	—	—	V	I _C =-1mA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	-50	—	—	V	I _E =-50μA
コレクタしゃ断電流	I _{CB0}	—	—	-0.5	μA	V _{CB} =-50V
エミッタしゃ断電流	I _{EBO}	—	—	-0.5	μA	V _{EB} =-4V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	—	-0.3	V	I _C =-5mA, I _B =-0.5mA
直流電流増幅率	h _{FE}	100	250	600	—	V _{CE} =5V, I _C =1mA
入力抵抗	R ₁	—	47	—	kΩ	—

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 標準品・準標準品一覧表 (○：準標準品)

Type	包装名	テーピング	
	記 号	T108	T109
	基本発注単位(個)	3000	3000
IMB14A		○	○

● 電気的特性曲線／Electrical Characteristic Curves

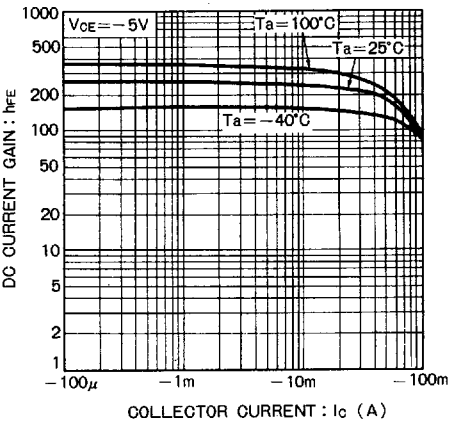


Fig.1 直流電流増幅率－コレクタ電流特性

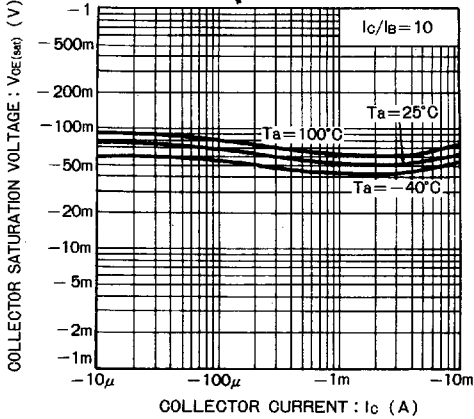


Fig.2 コレクタ・エミッタ飽和電圧－コレクタ電流特性